

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number : 06-202153

(43) Date of publication of application : 22.07.1994

(51)Int.Cl. G02F 1/136
H01L 29/784

(21) Application number : 04-348260

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(22) Date of filing : 28.12.1992

(72)Inventor : TAKIZAWA HIDEAKI

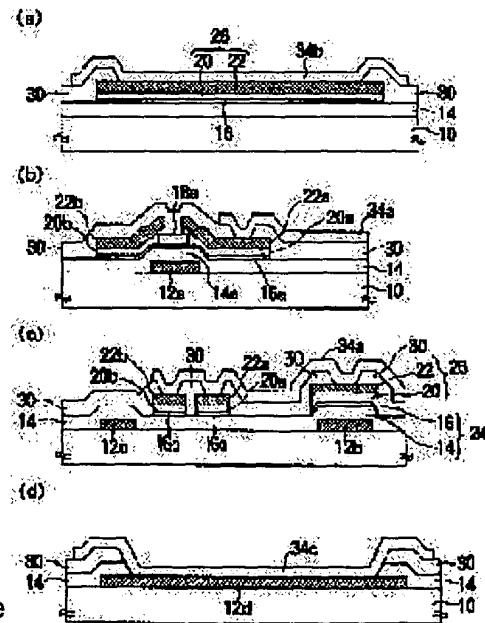
NASU YASUHIRO
WATANABE KAZUHIRO
HIROTA SHIRO
NONAKA KAZUO
SATO KIYOTAKE
MAJIMA NIWAJI

(54) THIN-FILM TRANSISTOR MATRIX DEVICE AND ITS PRODUCTION

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide the TFT matrix device which can be reduced in cost by simplifying production process and can be enhanced in performance by preventing the fluctuation in the characteristics of storage capacity.

CONSTITUTION: A gate terminal part is constituted of a gate terminal lower electrode 12d and a gate terminal upper electrode 34c which is laminated on this gate terminal lower electrode 12d via an insulating film 14 constituting a common layer with a gate insulating film 14a thereon and a contact hole opened in a passivation film 30 and consists of a transparent electrode of the same material as the material of a pixel electrode 34a. The storage capacity part is constituted of a Cs electrode 12b, a dielectric substance film 24 consisting of an insulating film 14 and i type a-Si layer 16 thereon and a counter electrode 26 consisting of an n+ type a-Si layer 20 and metallic layer 22 thereon. This counter electrode 26 is connected via the contact hole opened in the passivation film 30 to the pixel electrode 34a.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 03.07.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal of application]

[Patent number] 3098345

[Date of registration] 11.08.2000

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C) 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-202153

(43)公開日 平成6年(1994)7月22日

(51)Int.Cl. C 0 2 F H 0 1 L	識別記号 5 0 0 29/784	序内整理番号 9018-2K	F I	技術表示箇所
		9056-4M	H 0 1 L 29/ 78	3 1 1 A

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全 26 頁)

(21)出願番号 (22)出願日	特願平4-348260 平成4年(1992)12月28日	(71)出願人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 (72)発明者 滝沢 英明 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 (72)発明者 那須 安宏 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 (72)発明者 渡辺 和廣 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 (74)代理人 弁理士 北野 好人
---------------------	---------------------------------	--

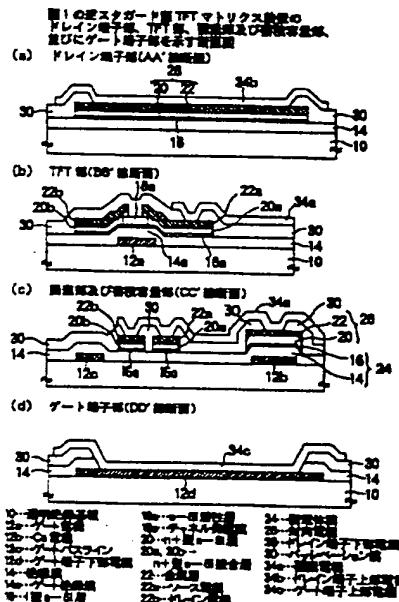
最終頁に続く

(54)【発明の名称】薄膜トランジスタマトリクス装置及びその製造方法

(57)【要約】

【目的】本発明は、製造工程を簡略化して低価格化を実現すると共に、蓄積容量の特性変動を防止して高性能化を実現することができる TFT マトリクス装置及びその製造方法を提供することを目的とする。

【構成】ゲート端子部は、ゲート端子下部電極 1 2 d と、その上のゲート絶縁膜 1 4 a と共に層をなす絶縁膜 1 4 及びバッシャーション膜 3 0 に開口されたコンタクトホール 3 2 d を介してゲート端子下部電極 1 2 d 上に積層され、画素電極 3 4 a と同一材料の透明電極からなるゲート端子上部電極 3 4 c とから構成され、蓄積容量部は、C s 電極 1 2 b と、その上の絶縁膜 1 4 及び i 型 a - S i 層 1 6 からなる誘電体膜 2 4 と、その上の n + 型 a - S i 層 2 0 及び金属層 2 2 からなる対向電極 2 6 とから構成され、この対向電極 2 6 はバッシャーション膜 3 0 に開口されたコンタクトホール 3 2 b を介して画素電極 3 4 a に接続する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 透明絶縁基板と、

前記透明絶縁基板上に形成されたゲート電極と、前記ゲート電極上にゲート絶縁膜を介して形成された半導体活性層と、前記半導体活性層上に半導体接合層を介して形成された相対するソース電極及びドレイン電極と、前記ソース電極及びドレイン電極を覆うバッシベーション膜とを有する薄膜トランジスタ部と、
 前記薄膜トランジスタ部の前記ソース電極に接続して形成された画素電極を有する画素部と、
 前記画素部の前記画素電極に接続して設けられた蓄積容量部と、
 前記薄膜トランジスタ部の前記ゲート電極にゲートバスラインを介して接続されたゲート端子部と、
 前記薄膜トランジスタ部の前記ドレイン電極にドレインバスラインを介して接続されたドレイン端子部とを備えた薄膜トランジスタマトリクス装置において、
 前記蓄積容量部が、前記透明絶縁基板上に形成され、前記ゲート電極と同一材料の金属層からなる蓄積容量電極と、前記蓄積容量電極上に形成され、前記ゲート絶縁膜と共通の層をなす絶縁膜及び前記半導体活性層と同一材料のノンドープ半導体層からなる誘電体膜と、前記誘電体膜上に形成され、前記半導体接合層と同一材料の不純物半導体層並びに前記ソース電極及びドレイン電極と同一材料の金属層からなる対向電極とを有すると共に、前記対向電極が、前記バッシベーション膜と共通の層をなす保護膜に開口されたコンタクトホールを介して、前記画素電極に接続されていることを特徴とする薄膜トランジスタマトリクス装置。

【請求項 2】 透明絶縁基板と、

前記透明絶縁基板上に形成されたゲート電極と、前記ゲート電極上にゲート絶縁膜を介して形成された半導体活性層と、前記半導体活性層上に半導体接合層を介して形成された相対するソース電極及びドレイン電極と、前記ソース電極及びドレイン電極を覆うバッシベーション膜とを有する薄膜トランジスタ部と、
 前記薄膜トランジスタ部の前記ソース電極に接続して形成された画素電極を有する画素部と、
 前記画素部の前記画素電極に接続して設けられた蓄積容量部と、
 前記薄膜トランジスタ部の前記ゲート電極にゲートバスラインを介して接続されたゲート端子部と、
 前記薄膜トランジスタ部の前記ドレイン電極にドレインバスラインを介して接続されたドレイン端子部とを備えた薄膜トランジスタマトリクス装置において、
 前記蓄積容量部が、前記透明絶縁基板上に形成され、前記ゲート電極と同一材料の金属層からなる蓄積容量電極と、前記蓄積容量電極上に形成され、前記ゲート絶縁膜と共通の層をなす絶縁膜及び前記バッシベーション膜と共通の層をなす保護膜からなる誘電体膜とを有し、前記

誘電体膜上に形成された前記画素電極を対向電極とすることを特徴とする薄膜トランジスタマトリクス装置。

【請求項 3】 透明絶縁基板と、

前記透明絶縁基板上に形成されたゲート電極と、前記ゲート電極上にゲート絶縁膜を介して形成された半導体活性層と、前記半導体活性層上に半導体接合層を介して形成された相対するソース電極及びドレイン電極と、前記ソース電極及びドレイン電極を覆うバッシベーション膜とを有する薄膜トランジスタ部と、
 前記薄膜トランジスタ部の前記ソース電極に接続して形成された画素電極を有する画素部と、
 前記画素部の前記画素電極に接続して設けられた蓄積容量部と、
 前記薄膜トランジスタ部の前記ゲート電極にゲートバスラインを介して接続されたゲート端子部と、
 前記薄膜トランジスタ部の前記ドレイン電極にドレインバスラインを介して接続されたドレイン端子部とを備えた薄膜トランジスタマトリクス装置において、
 前記ゲート端子部が、前記透明絶縁基板上に形成され、前記ゲート電極と共通の層をなす金属層からなるゲート端子下部電極と、前記ゲート絶縁膜と共通の層をなす絶縁膜及び前記バッシベーション膜と共通の層をなす保護膜に開口されたコンタクトホールを介して前記ゲート端子下部電極上に積層され、前記画素電極と同一材料の透明導電膜からなるゲート端子上部電極とを有することを特徴とする薄膜トランジスタマトリクス装置。

【請求項 4】 透明絶縁基板上に、第1の金属層を成膜した後、前記第1の金属層を所定の形状にパターニングして、ゲート電極、蓄積容量電極、前記ゲート電極に接続するゲートバスライン、及び前記ゲートバスラインに接続するゲート端子下部電極を形成する工程と、

全面に、絶縁膜及びノンドープ半導体層を順に成膜して、前記ゲート電極上に前記絶縁膜からなるゲート絶縁膜を形成する工程と、

全面に、不純物半導体層及び第2の金属層を順に成膜した後、前記第2の金属層、前記不純物半導体層、及び前記ノンドープ半導体層を所定の形状にパターニングして、前記ゲート絶縁膜上に前記ノンドープ半導体層からなる半導体活性層を形成すると共に、前記半導体活性層上に前記不純物半導体層からなる半導体接合層を介して前記第2の金属層からなるソース電極及びドレイン電極をそれぞれ対して形成し、前記蓄積容量電極上の前記絶縁膜及び前記ノンドープ半導体層からなる誘電体膜を形成すると共に、前記誘電体膜上に前記不純物半導体層及び前記第2の金属層からなる対向電極を形成し、前記不純物半導体層及び前記第2の金属層からなるドレイン端子下部電極を前記ドレイン電極に接続させて形成する工程と、

全面に、バッシベーション膜を成膜した後、前記ソース電極、前記対向電極、及び前記ドレイン端子下部電極上

の前記バッジベーション膜、並びに前記ゲート端子下部電極上の前記バッジベーション膜及び前記絶縁膜に第1乃至第4のコンタクトホールをそれぞれ開口する工程と、

全面に透明導電膜を成膜した後、前記透明導電膜を所定の形状にバーニングして、前記第1及び第2のコンタクトホールを介して前記ソース電極及び前記対向電極に接続する画素電極を形成し、前記第3のコンタクトホールを介して前記ドレイン端子下部電極に接続するドレイン端子上部電極を形成し、前記第4のコンタクトホールを介して前記ゲート端子下部電極に接続するゲート端子上部電極を形成する工程とを有することを特徴とする薄膜トランジスタマトリクス装置の製造方法。

【請求項5】 透明絶縁基板上に、第1の金属層を成膜した後、前記第1の金属層を所定の形状にバーニングして、ゲート電極、蓄積容量電極、前記ゲート電極に接続するゲートバスライン、及び前記ゲートバスラインに接続するゲート端子下部電極を形成する工程と、

全面に、絶縁膜及びノンドープ半導体層を順に成膜して、前記ゲート電極上に前記絶縁膜からなるゲート絶縁膜を形成する工程と、

全面に、不純物半導体層及び第2の金属層を順に成膜した後、前記第2の金属層、前記不純物半導体層、及び前記ノンドープ半導体層を所定の形状にバーニングして、前記ゲート絶縁膜上に前記ノンドープ半導体層からなる半導体活性層を形成すると共に、前記半導体活性層上に前記不純物半導体層からなる半導体接合層を介して前記第2の金属層からなるソース電極及びドレイン電極をそれぞれ相対して形成し、前記不純物半導体層及び前記第2の金属層からなるドレイン端子下部電極を前記ドレイン電極に接続させて形成する工程と、

全面にバッジベーション膜を成膜して、前記蓄積容量電極上の前記絶縁膜及び前記バッジベーション膜からなる誘電体膜を形成した後、前記ソース電極及び前記ドレイン端子下部電極上の前記バッジベーション膜、並びに前記ゲート端子下部電極上の前記バッジベーション膜及び前記絶縁膜に第1乃至第3のコンタクトホールをそれぞれ開口する工程と、

全面に透明導電膜を成膜した後、前記透明導電膜を所定の形状にバーニングして、前記第1のコンタクトホールを介して前記ソース電極に接続すると共に、前記蓄積容量電極上の前記誘電体膜を介して対向電極となる画素電極を形成し、前記第2のコンタクトホールを介して前記ドレイン端子下部電極に接続するドレイン端子上部電極を形成し、前記第3のコンタクトホールを介して前記ゲート端子下部電極に接続するゲート端子上部電極を形成する工程とを有することを特徴とする薄膜トランジスタマトリクス装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明はTFT（薄膜トランジスタ）マトリクス装置及びその製造方法に係り、特にラップトップパソコンや壁掛けTVとして用いられるTFT-LCD（TFTマトリクス型液晶ディスプレー装置）及びその製造方法に関する。TFT-LCDは薄型軽量、低消費電力等の特徴を有し、CRTに代わるディスプレー装置として将来大きな市場をもつことが期待されている。このため、その高性能化、低価格化を実現するための製造技術の開発が重要な課題となっている。

【0002】

【従来の技術】従来の逆スタガード型TFTマトリクス装置を、図17及び図18を用いて説明する。ここで、図17は従来によるTFTマトリクス装置を示す平面図、図18(a)、(b)、(c)、(d)はそれぞれそのドレイン端子部を示すAA'線断面図、TFT部を示すBB'線断面図、画素部及び蓄積容量部を示すCC'線断面図、並びにゲート端子部を示すDD'線断面図である。

【0003】TFTマトリクス装置のTFT部においては、透明絶縁基板50上に、例えばAl(アルミニウム)又はCr(クロム)等の金属層からなるゲート電極52aが形成されている。また、このゲート電極52a上にはゲート絶縁膜54aを介して、a-Si(アモルファスシリコン)活性層56aが形成されている。そしてこのa-Si活性層56a上には、チャネル保護膜58aが形成され、またこのチャネル保護膜58aの両側には、n+型a-Si接合層60a、60bを介してそれぞれa-Si活性層56aに接続するソース電極62a及びドレイン電極62bが形成されている。更に、このように構成されたTFTをバッジベーション膜70が覆っている。

【0004】また、画素部においては、ソース電極62aに接続されたITO(インジウム錫酸化物)等の透明導電膜からなる画素電極68aが形成されており、TFTを覆うバッジベーション膜70に開口した窓72aを介して露出している。また、蓄積容量部においては、透明絶縁基板50上に、ゲート電極52aと同一材料の金属層からなるCs(蓄積容量)電極52bが形成され、このCs電極52b上に、ゲート絶縁膜54aと共に共通の層をなす絶縁膜54からなる誘電体膜54bが形成され、更にこの誘電体膜54b上に、対向電極として機能する画素電極68aが形成されている。こうして、誘電体膜54bを間に挟むCs電極52bと対向電極としての画素電極68aとから蓄積容量部が構成されている。

【0005】また、ドレイン端子部においては、ドレイン端子下部電極64が、n+型a-Si接合層60b及びドレイン電極62bと共に共通の層をなすn+型a-Si層60及び金属層62から形成されている。そしてこのドレイン端子下部電極64上には、画素電極68aと同一材料の透明導電膜からなるドレイン端子上部電極68

bが積層されている。このようにドレイン端子上部電極6 8 bがドレイン端子下部電極6 4を覆っているのは、ドレイン端子下部電極6 4表面のA 1又はC r等の金属層6 2が酸化することを防止するためである。

【0006】こうして、ドレイン端子部は、ドレイン電極6 2 bにドレインバスライン7 4を介して接続するドレイン端子下部電極6 4と、このドレイン端子下部電極6 4上及びパッシベーション膜7 0上に形成されたドレイン端子上部電極6 8 bとから構成され、そのドレイン端子上部電極6 8 bがパッシベーション膜7 0に開口した窓7 2 bを介して露出している。

【0007】また、ゲート端子部においては、ゲート端子下部電極5 2 dが、ゲート電極5 2 a及びゲートバスライン5 2 cと共に層をなす金属層から形成されている。また、画素電極6 8 aと同一材料の透明導電膜からなるゲート端子上部電極6 8 cが、ゲート端子下部電極5 2 d上に積層されたゲート絶縁膜5 4 aと共に層をなす絶縁膜5 4に開口されているコンタクトホール6 6を介して、ゲート端子下部電極5 2 d上に積層されている。このようにゲート端子上部電極6 8 cがゲート端子下部電極5 2 dを覆っているのは、A 1又はC r等の金属層からなるゲート端子下部電極5 2 dが酸化することを防止するためである。

【0008】こうして、ゲート端子部は、ゲート電極5 2 aにゲートバスライン5 2 cを介して接続するゲート端子下部電極5 2 dと、このゲート端子下部電極5 2 d上及び絶縁膜5 4上に積層されたゲート端子上部電極6 8 cとから構成され、そのゲート端子上部電極6 8 cがパッシベーション膜7 0に開口した窓7 2 cを介して露出している。

【0009】次に、図17及び図18に示すTFTマトリクス装置の製造方法を、図19乃至図28の工程断面図を用いて説明する。尚、各図の(a)、(b)、(c)、(d)はそれぞれ図1のAA'線断面、BB'線断面、CC'線断面、DD'線断面に対応したドレイン端子部、TFT部、画素部及び蓄積容量部、並びにゲート端子部を示す。

【0010】透明絶縁基板5 0上に、例えばA 1又はC r等の金属層を成膜した後、所定の形状にバーニングして、ゲート電極5 2 a、Cs電極5 2 b、ゲート電極5 2 aに接続するゲートバスライン5 2 c、及びこのゲートバスライン5 2 cに接続するゲート端子下部電極5 2 dをそれぞれ形成する(図19参照)。次いで、全面に、絶縁膜5 4を成膜する。尚、ここで、ゲート電極5 2 a上の絶縁膜5 4を特にゲート絶縁膜5 4 aと、Cs電極5 2 b上の絶縁膜5 4を特に誘電体膜5 4 bと呼ぶ。統いて、この絶縁膜5 4上に、ノンドープのi型a-Si層5 6及び保護膜5 8を順に成膜する(図20参照)。

【0011】次いで、この保護膜5 8を、TFTチャネ

ル部を除いて、全てエッティング除去する。即ち、TFT部のゲート電極5 2 a上方にのみ保護膜5 8を残存させて、チャネル保護膜5 8 aを形成する(図21参照)。次いで、全面に、n+型a-Si層6 0を成膜した後、更に例えばA 1又はC r等の金属層6 2を成膜する(図22参照)。

【0012】次いで、金属層6 2、n+型a-Si層6 0、及びi型a-Si層5 6を選択的にエッティングして、TFT部のゲート絶縁膜5 4 a上にi型a-Si層5 6からなるa-Si活性層5 6 aを形成すると共に、チャネル保護膜5 8 aの両側のn+型a-Si層6 0からなるn+型a-Si接合層6 0 a、6 0 bを介してそれぞれa-Si活性層5 6 aに接続する金属層6 2からなるソース電極6 2 a及びドレイン電極6 2 bを相対して形成し、TFTを完成させる。

【0013】また同時に、ドレイン端子部において、ドレイン電極6 2 bにドレインバスラインを介して接続するn+型a-Si層6 0及び金属層6 2からなるドレイン端子下部電極6 4を形成する(図23参照)。次いで、レジストを塗布した後、フォトリソグラフィ法を用いて、ゲート端子下部電極5 2 d上に開口部をもつレジストパターンを形成する。そしてこのレジストパターンをマスクとして絶縁膜5 4をエッティングし、コンタクトホール6 6を開口する(図24参照)。

【0014】次いで、全面に、ITO等からなる透明導電膜6 8を成膜する(図25参照)。次いで、この透明導電膜6 8を所定の形状にバーニングし、ソース電極6 2 aに接続する画素電極6 8 aを形成し、同時に、ドレイン端子下部電極6 4に接続するドレイン端子上部電極6 8 bを形成し、コンタクトホール6 6を介してゲート端子下部電極5 2 dに接続するゲート端子上部電極6 8 cを形成する。尚、このとき、ソース電極6 2 aに接続する画素電極6 8 aは、Cs電極5 2 b上の誘電体膜5 4 bを覆っている。

【0015】こうして、Cs電極5 2 b、Cs電極5 2 bの対向電極として機能する画素電極6 8 a、及びこれら両電極間に挟まれた誘電体膜5 4 bからなる蓄積容量部を完成させる(図26参照)。次いで、全面に、パッシベーション膜7 0を成膜し、完成させたTFTを覆う(図27参照)。

【0016】次いで、レジストを塗布した後、フォトリソグラフィ法を用いて、画素電極6 8 a、ドレイン端子上部電極6 8 b、及びゲート端子上部電極6 8 c上にそれぞれ開口部をもつレジストパターンを形成する。そしてこのレジストパターンをマスクとしてパッシベーション膜7 0をエッティングし、それぞれ窓7 2 a、7 2 b、7 2 cを開口して、画素電極6 8 a、ドレイン端子上部電極6 8 b、及びゲート端子上部電極6 8 cを露出させる。

【0017】こうして、TFTのソース電極6 2 aに接

続する画素電極 6 8 a からなる画素部、TFT のドレン電極 6 2 b にドレンバスラインを介して接続するドレン端子下部電極 6 4 及びドレン端子上部電極 6 8 b からなるドレン端子部、並びに TFT のゲート電極 5 2 a にゲートバスライン 5 2 c を介して接続するゲート端子下部電極 5 2 d 及びゲート端子上部電極 6 8 c からなるゲート端子部をそれぞれ完成させる(図 28 参照)。

【0018】

【発明が解決しようとする課題】このような上記従来の TFT マトリクス装置の製造方法においては、ゲート端子部を形成する場合、透明絶縁基板 5 0 上にゲート端子下部電極 5 2 d を形成し(図 19 参照)、このゲート端子下部電極 5 2 d 上に絶縁膜 5 4 を成膜し(図 20 参照)、この絶縁膜 5 4 をエッチングしてコンタクトホール 6 6 を開口し(図 24 参照)、このコンタクトホール 6 6 を介してゲート端子下部電極 5 2 d に接続するゲート端子上部電極 6 8 c を形成し(図 26 参照)、このゲート端子上部電極 6 8 c 上にパッシベーション膜 7 0 を成膜し(図 27 参照)、このパッシベーション膜 7 0 をエッチングして窓 7 2 c を開口し、ゲート端子上部電極 6 8 c 上面を露出させる(図 27 参照)する。

【0019】即ち、図 24 に示される、ゲート端子下部電極 5 2 d 上の絶縁膜 5 4 を選択的にエッチングしてコンタクトホール 6 6 を開口する工程と、図 28 に示される、ゲート端子上部電極 6 8 c 上のパッシベーション膜 7 0 を選択的にエッチングして窓 7 2 c を開口し、最終的なゲート端子出しをする工程との 2 回の窓開け工程が必要であった。

【0020】そしてこれら 2 回の窓開け工程には、それぞれレジストパターンを作成するためのフォトリソグラフィ工程と、エッチング工程と、レジスト除去工程とが含まれる。従って、TFT-LCD の低価格化を実現するためには、こうした窓開け工程の数をできるだけ減らして、工程の簡略化を図ることが望ましい。また、図 23 に示されるように、金属層 6 2 、n+ 型 a-Si 層 6 0 、及び i 型 a-Si 層 5 6 の選択的なエッチングにより、TFT 部のゲート絶縁膜 5 4 a 上に a-Si 活性層 5 6 a を形成し、この a-Si 活性層 5 6 a にそれぞれ n+ 型 a-Si 接合層 6 0 a 、6 0 b を介して接続するソース電極 6 2 a 及びドレン電極 6 2 b を形成する工程においては、Cs 電極 5 2 b 上の誘電体膜 5 4 b が直接エッチャントに晒されるため、誘電体膜 5 4 b の厚さに変化が生じ、蓄積容量が変動するという問題があった。

【0021】更に、このとき、誘電体膜 5 4 b の一部にピンホール等があると、エッチャントの浸透により誘電体膜 5 4 b の絶縁不良を生じ、Cs 電極 5 2 b とその対向電極として機能する画素電極 6 8 a との間に電流リーカやショートを引き起こして表示欠陥を生じるおそれも

あった。そこで本発明は、製造工程を簡略化して低価格化を実現すると共に、蓄積容量の特性変動を防止して高性能化を実現することができる TFT マトリクス装置及びその製造方法を提供することを目的とする。

【0022】

【課題を解決するための手段】上記課題は、透明絶縁基板と、前記透明絶縁基板上に形成されたゲート電極と、前記ゲート電極上にゲート絶縁膜を介して形成された半導体活性層と、前記半導体活性層上に半導体接合層を介して形成された相対するソース電極及びドレン電極と、前記ソース電極及びドレン電極を覆うパッシベーション膜とを有する薄膜トランジスタ部と、前記薄膜トランジスタ部の前記ソース電極に接続して形成された画素電極を有する画素部と、前記画素部の前記画素電極に接続して設けられた蓄積容量部と、前記薄膜トランジスタ部の前記ゲート電極にゲートバスラインを介して接続されたゲート端子部と、前記薄膜トランジスタ部の前記ドレン電極にドレンバスラインを介して接続されたドレン端子部とを備えた薄膜トランジスタマトリクス装置において、前記蓄積容量部が、前記透明絶縁基板上に形成され、前記ゲート電極と同一材料の金属層からなる蓄積容量電極と、前記蓄積容量電極上に形成され、前記ゲート絶縁膜と共に層をなす絶縁膜及び前記半導体活性層と同一材料のノンドープ半導体層からなる誘電体膜と、前記誘電体膜上に形成され、前記半導体接合層と同一材料の不純物半導体層並びに前記ソース電極及びドレン電極と同一材料の金属層からなる対向電極とを有すると共に、前記対向電極が、前記パッシベーション膜と共に層をなす保護膜に開口されたコンタクトホールを介して、前記画素電極に接続されていることを特徴とする薄膜トランジスタマトリクス装置によって達成される。

【0023】また、透明絶縁基板と、前記透明絶縁基板上に形成されたゲート電極と、前記ゲート電極上にゲート絶縁膜を介して形成された半導体活性層と、前記半導体活性層上に半導体接合層を介して形成された相対するソース電極及びドレン電極と、前記ソース電極及びドレン電極を覆うパッシベーション膜とを有する薄膜トランジスタ部と、前記薄膜トランジスタ部の前記ソース電極に接続して形成された画素電極を有する画素部と、前記画素部の前記画素電極に接続して設けられた蓄積容量部と、前記薄膜トランジスタ部の前記ゲート電極にゲートバスラインを介して接続されたゲート端子部と、前記薄膜トランジスタ部の前記ドレン電極にドレンバスラインを介して接続されたドレン端子部とを備えた薄膜トランジスタマトリクス装置において、前記蓄積容量部が、前記透明絶縁基板上に形成され、前記ゲート電極と同一材料の金属層からなる蓄積容量電極と、前記蓄積容量電極上に形成され、前記ゲート絶縁膜と共に層をなす絶縁膜及び前記パッシベーション膜と共に層を

なす保護膜からなる誘電体膜とを有し、前記誘電体膜上に形成された前記画素電極を対向電極とすることを特徴とする薄膜トランジスタマトリクス装置によって達成される。

【0024】また、透明絶縁基板と、前記透明絶縁基板上に形成されたゲート電極と、前記ゲート電極上にゲート絶縁膜を介して形成された半導体活性層と、前記半導体活性層上に半導体接合層を介して形成された相対するソース電極及びドレイン電極と、前記ソース電極及びドレイン電極を覆うパッシベーション膜とを有する薄膜トランジスタ部と、前記薄膜トランジスタ部の前記ソース電極に接続して形成された画素電極を有する画素部と、前記画素部の前記画素電極に接続して設けられた蓄積容量部と、前記薄膜トランジスタ部の前記ゲート電極にゲートバスラインを介して接続されたゲート端子部と、前記薄膜トランジスタ部の前記ドレイン電極にドレインバスラインを介して接続されたドレイン端子部とを備えた薄膜トランジスタマトリクス装置において、前記ゲート端子部が、前記透明絶縁基板上に形成され、前記ゲート電極と共に層をなす金属層からなるゲート端子下部電極と、前記ゲート絶縁膜と共に層をなす絶縁膜及び前記パッシベーション膜と共に層をなす保護膜に開口されたコンタクトホールを介して前記ゲート端子下部電極上に積層され、前記画素電極と同一材料の透明導電膜からなるゲート端子上部電極とを有することを特徴とする薄膜トランジスタマトリクス装置によって達成される。

【0025】更に、上記課題は、透明絶縁基板上に、第1の金属層を成膜した後、前記第1の金属層を所定の形状にパターニングして、ゲート電極、蓄積容量電極、前記ゲート電極に接続するゲートバスライン、及び前記ゲートバスラインに接続するゲート端子下部電極を形成する工程と、全面に、絶縁膜及びノンドープ半導体層を順に成膜して、前記ゲート電極上に前記絶縁膜からなるゲート絶縁膜を形成する工程と、全面に、不純物半導体層及び第2の金属層を順に成膜した後、前記第2の金属層、前記不純物半導体層、及び前記ノンドープ半導体層を所定の形状にパターニングして、前記ゲート絶縁膜上に前記ノンドープ半導体層からなる半導体活性層を形成すると共に、前記半導体活性層上に前記不純物半導体層からなる半導体接合層を介して前記第2の金属層からなるソース電極及びドレイン電極をそれぞれ対して形成し、前記蓄積容量電極上の前記絶縁膜及び前記ノンドープ半導体層からなる誘電体膜を形成すると共に、前記ゲート端子下部電極上に前記パッシベーション膜、並びに前記ゲート端子下部電極上の前記パッシベーション膜及び前記絶縁膜に第1乃至第3のコンタクトホールをそれぞれ開口する工程と、全面に透明導電膜を成膜した後、前記透明導電膜を所定の形状にパターニングして、前記第1のコンタクトホールを介して前記ソース電極に接続すると共に、前記蓄積容量電極上の前記誘電体膜を介して対向電極となる画素電極を形成し、前記第2のコンタクトホールを介して前記ドレイン端子下部電極に接続するドレイン端子上部電極を形成し、前記第3のコンタクトホールを介して前記ゲート端子下部電極に接続するゲート端子上部電極を形成する工程とを有することを特徴とする薄膜トランジスタマトリクス装置の製造方法によって達成される。

【0026】また、透明絶縁基板上に、第1の金属層を成膜した後、前記第1の金属層を所定の形状にパターニングして、ゲート電極、蓄積容量電極、前記ゲート電極に接続するゲートバスライン、及び前記ゲートバスラインに接続するゲート端子下部電極を形成する工程と、全面に、絶縁膜及びノンドープ半導体層を順に成膜して、前記ゲート電極上に前記絶縁膜からなるゲート絶縁膜を形成する工程と、全面に、不純物半導体層及び第2の金属層を順に成膜した後、前記第2の金属層、前記不純物半導体層、及び前記ノンドープ半導体層を所定の形状にパターニングして、前記ゲート絶縁膜上に前記ノンドープ半導体層からなる半導体活性層を形成すると共に、前記半導体活性層上に前記不純物半導体層からなる半導体接合層を介して前記第2の金属層からなるソース電極及びドレイン電極をそれぞれ対して形成し、前記不純物半導体層及び前記第2の金属層からなるドレイン端子下部電極を前記ドレイン電極に接続させて形成する工程と、全面にパッシベーション膜を成膜して、前記蓄積容量電極上の前記絶縁膜及び前記パッシベーション膜からなる誘電体膜を形成した後、前記ソース電極及び前記ドレイン端子下部電極上の前記パッシベーション膜、並びに前記ゲート端子下部電極上の前記パッシベーション膜及び前記絶縁膜に第1乃至第3のコンタクトホールをそれぞれ開口する工程と、全面に透明導電膜を成膜した後、前記透明導電膜を所定の形状にパターニングして、前記第1のコンタクトホールを介して前記ソース電極に接続すると共に、前記蓄積容量電極上の前記誘電体膜を介して対向電極となる画素電極を形成し、前記第2のコンタクトホールを介して前記ドレイン端子下部電極に接続するドレイン端子上部電極を形成し、前記第3のコンタクトホールを介して前記ゲート端子下部電極に接続するゲート端子上部電極を形成する工程とを有することを特徴とする薄膜トランジスタマトリクス装置の製造方法によって達成される。

【0027】
【作用】本発明は、ゲート端子部を形成する場合、ゲート電極と共に層をなす金属層からなるゲート端子下部電極上に、ゲート絶縁膜と共に層をなす絶縁膜及びパッシベーション膜と共に層をなす保護膜を積層した

後、これら絶縁膜及び保護膜に1回の窓明けを行ってコンタクトホールを開口し、このコンタクトホール内に露出されたゲート端子下部電極上に、画素電極と同一材料の透明導電膜からなるゲート端子上部電極を形成する。即ち、従来の製造方法に比較すると、パッシベーション膜と共に層をなす保護膜を成膜する工程と、ゲート端子上部電極を形成する透明導電膜を成膜する工程の順序を逆にする。

【0028】これにより、ゲート端子下部電極上の絶縁膜の窓明けとゲート端子上部電極上の保護膜の窓明けとを別々に行っていた従来の2回の窓明け工程を、積層した絶縁膜及び保護膜を1回の窓明け工程で済ますことができ、この開口されたコンタクトホールを介して接続するゲート端子下部電極及びゲート端子上部電極からなるゲート端子部を形成することができる。このため、TFTマトリクス装置の製造工程を簡略化することが可能となる。

【0029】また、蓄積容量部を形成する場合、蓄積容量電極上のゲート絶縁膜と共に層をなす絶縁膜上に、半導体活性層と同一材料のノンドープ半導体層を成膜した後、このノンドープ半導体層を絶縁膜と共に蓄積容量用の誘電体膜として用い、この誘電体膜上に、半導体接合層と同一材料の不純物半導体層並びにソース電極及びドレイン電極と同一材料の金属層からなる対向電極を形成する。そしてこの対向電極上の保護膜に開口されたコンタクトホールを介して、対向電極を画素電極に接続させる。

【0030】これにより、絶縁膜上に成膜されたノンドープ半導体層は除去されることなく、常に絶縁膜を覆っているため、この絶縁膜が直接エッチャントに晒されず、従って誘電体膜の厚さに変化が生じて蓄積容量が変動するということもない。また、このとき、絶縁膜の一部にピンホール等があっても、その上に積層されたノンドープ半導体層が誘電体膜の絶縁不良を防止し、従って電流リーカやショートによる表示欠陥を生じるおそれもない。

【0031】しかも、誘電体膜の一部をなすノンドープ半導体層及びその上の対向電極は、TFTの半導体活性層、半導体接合層、及びソース・ドレイン電極と同一材料を用いて同時に形成されるため、また対向電極と画素電極とを接続させるコンタクトホールの開口も、ゲート端子部の窓明け工程と同時に行われるため、新たに工程を増加させることはない。

【0032】このため、工程を増加させることなく、蓄積容量の特性変動を防止し、高歩留まり、高信頼性を実現することが可能となる。

【0033】

【実施例】以下、本発明を実施例に基づいて具体的に説明する。図1は本発明の第1の実施例による逆スタガード型TFTマトリクス装置を示す平面図、図2(a)、

(b)、(c)、(d)はそれぞれそのドレイン端子部を示すAA'線断面図、TFT部を示すBB'線断面図、画素部及び蓄積容量部を示すCC'線断面図、並びにゲート端子部を示すDD'線断面図である。

【0034】TFTマトリクス装置のTFT部においては、透明絶縁基板10上に、例えばAl又はCr等の金属層からなるゲート電極12aが形成されている。また、このゲート電極12a上には、SiN膜又はSiO₂膜とSiN膜との2層膜等からなるゲート絶縁膜14aを介して、a-Si活性層16aが形成されている。そしてこのa-Si活性層16a上には、チャネル保護膜18aが形成されているが、このチャネル保護膜18aの両側には、n+型a-Si接合層20a、20bを介してそれぞれa-Si活性層16aに接続するソース電極22a及びドレイン電極22bが相対して形成されている。更に、このように構成されたTFTをパッシベーション膜30が覆っている。

【0035】また、画素部においては、TFTを覆っているパッシベーション膜30に開口されたコンタクトホール32aを介して、ソース電極22aに接続されたITO等の透明導電膜からなる画素電極34aが形成されている。また、蓄積容量部においては、透明絶縁基板10上に、ゲート電極12aと同一材料の金属層からなるCs電極12bが形成されている。このCs電極12b上には、ゲート絶縁膜14aと共に層をなす絶縁膜14及びa-Si活性層16aと同一材料のノンドープのi型a-Si層16からなる誘電体膜24が形成され、更にこの誘電体膜24上には、n+型a-Si接合層20a、20bと同一材料のn+型a-Si層20及びソース・ドレイン電極22a、22bと同一材料の金属層22からなる対向電極26が形成されている。

【0036】そしてこの対向電極26は、パッシベーション膜30に開口されたコンタクトホール32bを介して、画素電極34aに接続されている。こうして、誘電体膜24を間に挟む対向電極26とCs電極12bとから構成される蓄積容量部が、画素電極34aに接続して形成されている。また、ドレイン端子部においては、ドレイン端子下部電極28が、n+型a-Si接合層20b及びドレイン電極22bと共に層をなすn+型a-Si層20及び金属層22から形成されている。そしてこのドレイン端子下部電極28は、TFTマトリクス装置の複数のドレイン電極22bにドレインバスライン36を介して接続されている。

【0037】また、このドレイン端子下部電極28上には、TFTを覆っているパッシベーション膜30に開口されたコンタクトホール32cを介して、画素電極34aと同一材料の酸化導電膜からなるドレイン端子上部電極34bが積層され、ドレイン端子下部電極28の酸化を防止している。こうして、ドレイン端子部は、透明絶縁基板10上のゲート絶縁膜14aと共に層をなす絶

緑膜 1 4 及び a-Si 活性層 1 6 a と同一材料のノンドープの i 型 a-Si 層 1 6 上に形成されたドレイン端子下部電極 2 8 と、このドレイン端子下部電極 2 8 上及びパッシベーション膜 3 0 上に形成されたドレイン端子上部電極 3 4 b とから構成され、外部制御回路と接続されるようになっている。

【0038】また、ゲート端子部においては、ゲート端子下部電極 1 2 d が、ゲート電極 1 2 a 及びゲートバスライン 1 2 c と共に層をなす金属層から形成されている。そしてこのゲート端子下部電極 1 2 d は、TFT マトリクス装置の複数のゲート電極 1 2 a にゲートバスライン 1 2 c を介して接続されている。また、このゲート端子下部電極 1 2 d 上には、ゲート絶縁膜 1 4 a と共に層をなす絶縁膜 1 4 及びパッシベーション膜 3 0 に開口されたコンタクトホール 3 2 d を介して、画素電極 3 4 a と同一材料の酸化導電膜からなるゲート端子上部電極 3 4 c が積層され、ゲート端子下部電極 1 2 d の酸化を防止している。

【0039】こうして、ゲート端子部は、透明絶縁基板 1 0 上に形成されたゲート端子下部電極 1 2 d と、このゲート端子下部電極 1 2 d 上並びに絶縁膜 1 4 及びパッシベーション膜 3 0 上に形成されたゲート端子上部電極 3 4 c とから構成され、外部制御回路と接続されるようになっている。次に、図 1 及び図 2 に示す逆スタガード型 TFT マトリクス装置の製造方法を、図 3 乃至図 11 の工程断面図を用いて説明する。尚、各図の (a)、(b)、(c)、(d) はそれぞれ図 1 の AA' 線断面、BB' 線断面、CC' 線断面、DD' 線断面に対応したドレイン端子部、TFT 部、画素部及び蓄積容量部、並びにゲート端子部を示す。

【0040】ガラス基板等の透明絶縁基板 1 0 上に、スパッタ法を用いて、例えば A 1 又は C r 等からなる金属層を成膜する。そしてこの金属層上に、所定のレジストパターンを形成した後、それをマスクとして金属層をエッチングして、ゲート電極 1 2 a、Cs 電極 1 2 b、ゲート電極 1 2 a に接続するゲートバスライン 1 2 c、及びこのゲートバスライン 1 2 c に接続するゲート端子下部電極 1 2 d をそれぞれ形成する。

【0041】尚、この金属層は、次の工程で全面に積層する絶縁膜と十分な選択エッチング性を有するものであれば、A 1 や C r に限らず、他の金属材料を使用してもよい（図 3 参照）。次いで、全面に、プラズマ CVD 法を用いて、SiN 膜又は SiO₂ 膜と SiN 膜との 2 層膜等からなる厚さ約 4 0 0 nm の絶縁膜 1 4 を成膜する。尚、ここで、ゲート電極 1 2 a 上の絶縁膜 1 4 を特にゲート絶縁膜 1 4 a と呼ぶ。

【0042】続いて、この絶縁膜 1 4 上に、プラズマ CVD 法を用いて、厚さ 2 0 nm のノンドープの i 型 a-Si 層 1 6 及び SiO₂ 膜又は SiN 膜からなる厚さ 1 5 0 nm の保護膜 1 8 を順に成膜する（図 4 参照）。次

いで、この保護膜 1 8 を、TFT チャネル部を除き、弗酸緩衝液等を用いて全てエッチング除去する。即ち、TFT 部のゲート電極 1 2 a 上方にのみ保護膜 1 8 を残存させて、チャネル保護膜 1 8 a を形成する（図 5 参照）。

【0043】次いで、全面に、プラズマ CVD 法を用いて、厚さ 6 0 nm の n+ 型 a-Si 層 2 0 を成膜した後、更にスパッタ法を用いて、厚さ 2 0 0 nm の例えは A 1 又は C r 等からなる金属層 2 2 を成膜する（図 6 参照）。次いで、この金属層 2 2 上に、所定のレジストパターンを形成した後、それをマスクとして金属層 2 2、n+ 型 a-Si 層 2 0、及び i 型 a-Si 層 1 6 を順にエッチングする。こうして、TFT 部のゲート絶縁膜 1 4 a 上に i 型 a-Si 層 1 6 からなる a-Si 活性層 1 6 a を形成すると共に、チャネル保護膜 1 8 a の両側の n+ 型 a-Si 層 2 0 からなる n+ 型 a-Si 接合層 2 0 a、2 0 b を介してそれぞれ a-Si 活性層 1 6 a に接続する金属層 2 2 からなるソース電極 2 2 a 及びドレン電極 2 2 b を相対して形成し、TFT を完成させる。

【0044】また同時に、蓄積容量部の Cs 電極 1 2 b 上に、絶縁膜 1 4 及び i 型 a-Si 層 1 6 からなる誘電体膜 2 4 を介して、n+ 型 a-Si 層 2 0 及び金属層 2 2 からなる対向電極 2 6 を形成する。更に、ドレン端子部において、ドレン電極 2 2 b にドレンバスライン（図示せず）を介して接続する n+ 型 a-Si 層 2 0 及び金属層 2 2 からなるドレン端子下部電極 2 8 を形成する（図 7 参照）。

【0045】次いで、全面に、CVD 法又はスパッタ法を用いて、SiN 膜、SiO₂ 膜、又はこれらの複合膜からなる厚さ 4 0 0 nm のパッシベーション膜 3 0 を成膜し、完成させた TFT を覆う（図 8 参照）。次いで、レジストを塗布した後、フォトリソグラフィ法を用いて、ソース電極 2 2 a、対向電極 2 6、ドレン端子下部電極 2 8、及びゲート端子下部電極 1 2 d 上にそれぞれ開口部をもつレジストパターンを形成する。そしてこのレジストパターンをマスクとしてパッシベーション膜 3 0 又はパッシベーション膜 3 0 及び絶縁膜 1 4 をエッチングし、コンタクトホール 3 2 a、3 2 b、3 2 c、3 2 d をそれぞれ開口する。

【0046】尚、このときのエッチングは、パッシベーション膜 3 0 又はパッシベーション膜 3 0 及び絶縁膜 1 4 をテーパエッチングするものであることが望ましい。コンタクトホール 3 2 a、3 2 b、3 2 c、3 2 d 内に露出したソース電極 2 2 a、対向電極 2 6、ドレン端子下部電極 2 8、及びゲート端子下部電極 1 2 d と、次の工程で成膜する ITO 等からなる透明導電膜とを電気的に接続する必要があるからである。そしてこのテーパエッチングは、弗酸緩衝液によるウエットエッチの他、CF₄ ガスによる RIE（反応性イオンエッチング）等

を用いてもよい(図9参照)。

【0047】次いで、全面に、スパッタ法等を用いて、厚さ100nmのITO等からなる透明導電膜34を成膜する(図10参照)。次いで、この透明導電膜34を所定の形状にバーニングし、コンタクトホール32a、32bを介してソース電極22a及び対向電極26に接続する画素電極34aを形成する。また同時に、コンタクトホール32cを介してドレイン端子下部電極28に接続するドレイン端子上部電極34bを形成し、コンタクトホール32dを介してゲート端子下部電極12dに接続するゲート端子上部電極34cを形成する。

【0048】こうして、TFT部のソース電極22aに接続する画素電極34aからなる画素部、この画素電極34aに接続する対向電極26、Cs電極12b、及びこれら両電極間に挟まれた誘電体膜24からなる蓄積容量部、TFT部のドレイン電極22bにドレインバスラインを介して接続するドレイン端子下部電極28及びドレイン端子上部電極34bからなるドレイン端子部、並びにTFT部のゲート電極12aにゲートバスライン12cを介して接続するゲート端子下部電極12d及びゲート端子上部電極34dからなるゲート端子部をそれぞれ完成させる(図11参照)。

【0049】このように本実施例によれば、ゲート端子部を形成する場合、透明絶縁基板10上に、A1又はCr等の金属層からなるゲート端子下部電極12dをゲート電極12a及びゲートバスライン12cと同時に形成し(図3参照)、このゲート端子下部電極12d上に、ゲート絶縁膜14aと共に層をなす絶縁膜14を成膜し(図4参照)、この絶縁膜14上に、TFTを覆うバッシャベーション膜30を成膜し(図8参照)、これらバッシャベーション膜30及び絶縁膜14をエッチングしてコンタクトホール32dを開口し(図9参照)、このコンタクトホール32dを介してゲート端子下部電極12dに接続する透明導電膜からなるゲート端子上部電極34cを、画素電極34aと同時に形成する(図10及び図11参照)。

【0050】このような製造工程を、従来の製造工程、即ち、ゲート端子下部電極52d上の絶縁膜54を選択的にエッチングしてコンタクトホール66を開口する工程(図24参照)と、ゲート端子上部電極68c上のバッシャベーション膜70を選択的にエッチングして窓72cを開口し、最終的なゲート端子出しをする工程(図28参照)との2回の窓明け工程を必要とする製造工程と比較すると、バッシャベーション膜30を成膜する工程とゲート端子上部電極34cを形成する透明導電膜34を成膜する工程の順序を逆にすることにより、ゲート端子下部電極12d上の絶縁膜14及びバッシャベーション膜30を1回の窓明け工程によって開口することができ、従来の2回の窓明け工程が1回の窓明け工程で済むことになる。従って、その分だけにTFTマトリクス装置の

製造工程が簡略化され、コストダウンを実現することが可能となる。

【0051】また、蓄積容量部を形成する場合、A1又はCr等の金属層からなるCs電極12bをゲート電極12a等と同時に形成し(図3参照)、このゲート電極12a上に、絶縁膜14及びノンドープのi型a-Si層16を成膜し(図4参照)、このi型a-Si層16上に、n+型a-Si層20及び金属層22を成膜して(図6参照)、絶縁膜14及びi型a-Si層16からなる誘電体膜24、及びn+型a-Si層20及び金属層22からなる対向電極26を形成する(図7参照)。更に、対向電極26上のバッシャベーション膜30にコンタクトホール32bを開口し(図9参照)、このコンタクトホール32bを介して対向電極26に接続する画素電極34aを形成する(図11参照)。

【0052】こうして、ゲート電極12a上の絶縁膜14を覆うi型a-Si層16は、誘電体膜24を構成する一部となると共に、絶縁膜14が直接エッチャントに晒されないように常に保護しているため、誘電体膜24の厚さの変化による蓄積容量の変動を防止することができる。また、このとき、絶縁膜14の一部にピンホールがあつても、絶縁膜14を覆っているi型a-Si層16の存在により誘電体膜24の絶縁不良を防ぎ、電流リーカやショートによる表示欠陥の発生を防止することができる。

【0053】尚、絶縁膜14及びi型a-Si層16からなる誘電体膜24を間に挟む対向電極26とCs電極12bとから構成される蓄積容量部の蓄積容量は、i型a-Si層16の厚さが20nmと極めて薄いため、従来のように絶縁膜14のみを誘電体膜とする蓄積容量部の場合と殆ど変わらない。しかも、誘電体膜24を構成するi型a-Si層16並びにその上のn+型a-Si層20及び金属層22からなる対向電極26は、それぞれTFT部のa-Si活性層16a、n+型a-Si結合層20a、20b及びソース電極22a及びドレイン電極22bと同一材料を用いて同時に形成される(図4及び図6参照)。また、対向電極26と画素電極34aとを接続させるコンタクトホール32bの開口も、ゲート端子部におけるコンタクトホール32d等の開口と同時に行われる(図9参照)。このため、新たに工程を増加させることはない。

【0054】従って、工程を増加させることなく、蓄積容量部における蓄積容量の特性変動や不良の発生を防止し、歩留まり及び信頼性を向上させることが可能となる。次に、本発明の第2の実施例による逆スタガード型TFTマトリクス装置を、図12及び図13を用いて説明する。ここで、図12は第2の実施例によるTFTマトリクス装置を示す平面図、図13(a)、(b)、(c)、(d)はそれぞれそのドレイン端子部を示すA-A'線断面図、TFT部を示すB-B'線断面図、画素部

及び蓄積容量部を示すCC'線断面図、並びにゲート端子部を示すDD'線断面図である。尚、上記図1及び図2に示すTFTマトリクス装置と同一の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。

【0055】本実施例によるTFTマトリクス装置は、上記図1及び図2に示すTFTマトリクス装置とは、そのドレイン端子部、TFT部、画素部、及びゲート端子部においては同様の構成をしているが、蓄積容量部の構成において異なっている。即ち、透明絶縁基板10上にゲート電極12aと同一材料の金属層からなるCs電極12bが形成されている点は同じであるが、このCs電極12b上にゲート絶縁膜14aと共に層をなす絶縁膜14及びバッシャーション膜30からなる誘電体膜38が形成され、更にこの誘電体膜38上に画素電極34aが形成されている点で異なる。従って、この蓄積容量部は、画素電極34aが対向電極として機能し、誘電体膜38を間に挟む対向電極としての画素電極34aとCs電極12bとから構成されている。

【0056】次に、図12及び図13に示すTFTマトリクス装置の製造方法を、図14乃至図16の工程断面図を用いて説明する。尚、各図の(a)、(b)、(c)、(d)はそれぞれ図12のAA'線断面、BB'線断面、CC'線断面、DD'線断面に対応したドレイン端子部、TFT部、画素部及び蓄積容量部、並びにゲート端子部を示す断面図である。また、上記図3乃至図11に示すTFTマトリクス装置と同一の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。

【0057】上記図3乃至図6に示す工程と同様にして、透明絶縁基板10上に、ゲート電極12a、Cs電極12b、ゲート電極12aに接続するゲートバスライン12c、及びこのゲートバスライン12cに接続するゲート端子下部電極12dをそれぞれ形成した後、全面に、絶縁膜14及びノンドープのi型a-Si層16を順に成膜し、更にゲート電極12a上方のゲート絶縁膜14a上にチャネル保護膜18aを形成する。統いて、全面に、n+型a-Si層20及び金属層22を順に成膜する(図14参照)。

【0058】次いで、金属層22、n+型a-Si層20及びi型a-Si層16を選択的にエッチングして、ゲート絶縁膜14a上にa-Si活性層16aを形成すると共に、チャネル保護膜18aの両側のn+型a-Si接合層20a、20bを介してそれぞれa-Si活性層16aに接続するソース電極22a及びドレイン電極22bを形成し、TFTを完成させる。

【0059】また、同時に、ドレイン端子部において、ドレイン電極22bにドレインバスラインを介して接続するn+型a-Si層20及び金属層22からなるドレイン端子下部電極28を形成する。但し、上記第1の実施例と異なり、蓄積容量部のCs電極12b上に、i型a-Si層16、n+型a-Si層20、及び金属層2

2を残存させず、従って絶縁膜14及びi型a-Si層16からなる誘電体膜を形成することではなく、またn+型a-Si層20及び金属層22からなる対向電極を形成することもない(図15参照)。

【0060】次いで、上記図8乃至図11に示す工程と同様にして、全面に、バッシャーション膜30を成膜し、完成させたTFTを覆った後、このバッシャーション膜30又はバッシャーション膜30及び絶縁膜14を選択的にエッチングして、ソース電極22a、ドレイン端子下部電極28、及びゲート端子下部電極12d上にそれぞれコンタクトホールを開口する。但し、上記第1の実施例と異なり、対向電極がないため、この対向電極上にコンタクトホールを開口することはない。

【0061】統いて、全面に、透明導電膜34を成膜した後、この透明導電膜34を所定の形状にパターニングして、ソース電極22aに接続する画素電極34a、ドレイン端子下部電極28に接続するドレイン端子上部電極34b、及びゲート端子下部電極12dに接続するゲート端子上部電極34cをそれぞれ形成する。こうして、TFT部のソース電極22aに接続する画素電極34aからなる画素部、TFT部のドレイン電極22bにドレインバスラインを介して接続するドレイン端子下部電極28及びドレイン端子上部電極34bからなるドレイン端子部、並びにTFT部のゲート電極12aにゲートバスライン12cを介して接続するゲート端子下部電極12d及びゲート端子上部電極34cからなるゲート端子部をそれぞれ完成させる。

【0062】また、このとき、Cs電極12b上方にも、絶縁膜14及びバッシャーション膜30からなる誘電体膜38を介して画素電極34aが形成されるため、対向電極として機能する画素電極34a、Cs電極12b及び両電極間に挟まれた誘電体膜38からなる蓄積容量部も完成する(図16参照)。このように本実施例においても、バッシャーション膜30を成膜する工程の後に、ゲート端子上部電極34cを形成する透明導電膜34を成膜する工程を設けており、ゲート端子下部電極12d上の絶縁膜14及びバッシャーション膜30を1回の窓開け工程によって開口するため、上記第1の実施例の場合と同様に、TFTマトリクス装置の製造工程が簡略化され、コストダウンを実現することが可能となる。

【0063】但し、本実施例の場合、その蓄積容量部が、透明絶縁基板10上に形成されたCs電極12bと、このCs電極12b上に成膜された絶縁膜14及びバッシャーション膜30からなる誘電体膜38と、この誘電体膜38上に形成された対向電極として機能する画素電極34aから構成されている。即ち、その誘電体膜38の厚さが上記第1の実施例の場合と比較するとかなり厚くなっている。このため、本実施例は、蓄積容量部の蓄積容量が比較的小さくてもよい場合に適用することが望ましい。

【0064】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、透明絶縁基板上に、第1の金属層からなるゲート電極、蓄積容量電極、及びゲート端子下部電極を形成する工程と、ゲート電極上に、ゲート絶縁膜を形成する工程と、このゲート絶縁膜上の半導体活性層に半導体接合層を介してそれそれ接続するソース電極及びドレイン電極を形成し、同時に、蓄積容量電極上に、ゲート絶縁膜と共に層をなす絶縁膜及び半導体活性層と同一材料のノンドープ半導体層からなる誘電体膜を介して、半導体接合層と同一材料の不純物半導体層及びソース電極及びドレイン電極と同一材料の第2の金属層からなる対向電極を形成する工程と、ソース電極、対向電極、及びゲート端子下部電極上のバッシャーベーション膜又はバッシャーベーション膜及び絶縁膜にコンタクトホールを開口する工程と、それぞれのコンタクトホールを介して、ソース電極及び対向電極に接続する透明導電膜からなる画素電極を形成し、同時に、ゲート端子下部電極に接続するゲート端子上部電極を形成する工程とを有することにより、ゲート端子下部電極上に積層した絶縁膜及び保護膜を1回の窓明け工程で開口し、この開口されたコンタクトホールを介して接続するゲート端子下部電極及びゲート端子上部電極からなるゲート端子部を形成することができるため、TFTマトリクス装置の製造工程を簡略化することが可能となる。

【0065】また、蓄積容量電極上の絶縁膜がノンドープ半導体層によって常に覆われていることにより、絶縁膜が直接エッチャントに晒されず、従って絶縁膜及びノンドープ半導体層からなる誘電体膜の厚さが変動や絶縁不良を生じないため、蓄積容量の特性変動や電流リーク等による表示欠陥の発生を防止することができる。これにより、TFTマトリクス装置の製造工程を簡略化して、コストダウンを実現すると共に、蓄積容量の特性変動を防止して、歩留まり及び信頼性を向上させることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例による逆スタガード型TFTマトリクス装置を示す平面図である。

【図2】図1の逆スタガード型TFTマトリクス装置のドレイン端子部、TFT部、画素部及び蓄積容量部、並びにゲート端子部を示す断面図である。

【図3】図1及び図2の逆スタガード型TFTマトリクス装置の製造方法を説明するための工程断面図（その1）である。

【図4】図1及び図2の逆スタガード型TFTマトリクス装置の製造方法を説明するための工程断面図（その2）である。

【図5】図1及び図2の逆スタガード型TFTマトリクス装置の製造方法を説明するための工程断面図（その3）である。

【図6】図1及び図2の逆スタガード型TFTマトリクス装置の製造方法を説明するための工程断面図（その4）である。

【図7】図1及び図2の逆スタガード型TFTマトリクス装置の製造方法を説明するための工程断面図（その5）である。

【図8】図1及び図2の逆スタガード型TFTマトリクス装置の製造方法を説明するための工程断面図（その6）である。

【図9】図1及び図2の逆スタガード型TFTマトリクス装置の製造方法を説明するための工程断面図（その7）である。

【図10】図1及び図2の逆スタガード型TFTマトリクス装置の製造方法を説明するための工程断面図（その8）である。

【図11】図1及び図2の逆スタガード型TFTマトリクス装置の製造方法を説明するための工程断面図（その9）である。

【図12】本発明の第2の実施例による逆スタガード型TFTマトリクス装置を示す平面図である。

【図13】図12の逆スタガード型TFTマトリクス装置のドレイン端子部、TFT部、画素部及び蓄積容量部、並びにゲート端子部を示す断面図である。

【図14】図12及び図13の逆スタガード型TFTマトリクス装置の製造方法を説明するための工程断面図（その1）である。

【図15】図12及び図13の逆スタガード型TFTマトリクス装置の製造方法を説明するための工程断面図（その2）である。

【図16】図12及び図13の逆スタガード型TFTマトリクス装置の製造方法を説明するための工程断面図（その3）である。

【図17】従来の逆スタガード型TFTマトリクス装置を示す平面図である。

【図18】図17の逆スタガード型TFTマトリクス装置のドレイン端子部、TFT部、画素部及び蓄積容量部、並びにゲート端子部を示す断面図である。

【図19】図17及び図18の逆スタガード型TFTマトリクス装置の製造方法を説明するための工程断面図（その1）である。

【図20】図17及び図18の逆スタガード型TFTマトリクス装置の製造方法を説明するための工程断面図（その2）である。

【図21】図17及び図18の逆スタガード型TFTマトリクス装置の製造方法を説明するための工程断面図（その3）である。

【図22】図17及び図18の逆スタガード型TFTマトリクス装置の製造方法を説明するための工程断面図（その4）である。

【図23】図17及び図18の逆スタガード型TFTマ

トリクス装置の製造方法を説明するための工程断面図(その5)である。

【図24】図17及び図18の逆スタガード型TFTマトリクス装置の製造方法を説明するための工程断面図(その6)である。

【図25】図17及び図18の逆スタガード型TFTマトリクス装置の製造方法を説明するための工程断面図(その7)である。

【図26】図17及び図18の逆スタガード型TFTマトリクス装置の製造方法を説明するための工程断面図(その8)である。

【図27】図17及び図18の逆スタガード型TFTマトリクス装置の製造方法を説明するための工程断面図(その9)である。

【図28】図17及び図18の逆スタガード型TFTマトリクス装置の製造方法を説明するための工程断面図(その10)である。

【符号の説明】

1 0 … 透明絶縁基板

1 2 a … ゲート電極

1 2 b … C_s電極

1 2 c … ゲートバスライン

1 2 d … ゲート端子下部電極

1 4 … 絶縁膜

1 4 a … ゲート絶縁膜

1 6 … i型a-Si層

1 6 a … a-Si活性層

1 8 … 保護膜

1 8 a … チャネル保護膜

2 0 … n+型a-Si層

2 0 a、2 0 b … n+型a-Si接合層

2 2 … 金属層

2 2 a … ソース電極

2 2 b … ドレイン電極

2 4 … 誘電体膜

2 6 … 対向電極

2 8 … ドレイン端子下部電極

3 0 … パッシベーション膜

3 2 a、3 2 b、3 2 c、3 2 d … コンタクトホール

3 4 … 透明導電膜

3 4 a … 画素電極

3 4 b … ドレイン端子上部電極

3 4 c … ゲート端子上部電極

3 6 … ドレインバスライン

3 8 … 誘電体膜

5 0 … 透明絶縁基板

5 2 a … ゲート電極

5 2 b … C_s電極

5 2 c … ゲートバスライン

5 2 d … ゲート端子下部電極

5 4 … 絶縁膜

5 4 a … ゲート絶縁膜

5 4 b … 誘電体膜

5 6 … i型a-Si層

5 6 a … a-Si活性層

5 8 … 保護膜

5 8 a … チャネル保護膜

6 0 … n+型a-Si層

6 0 a、6 0 b … n+型a-Si接合層

6 2 … 金属層

6 2 a … ソース電極

6 2 b … ドレイン電極

6 4 … ドレイン端子下部電極

6 6 … コンタクトホール

6 8 … 透明導電膜

6 8 a … 画素電極

6 8 b … ドレイン端子上部電極

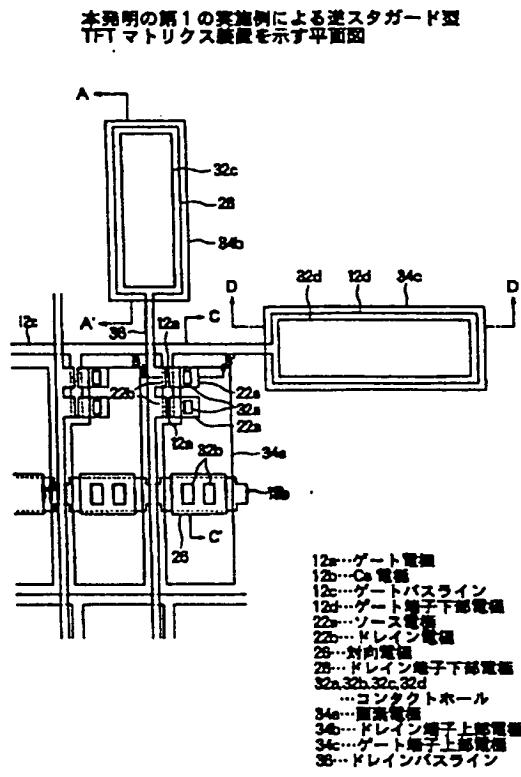
6 8 c … ゲート端子上部電極

7 0 … パッシベーション膜

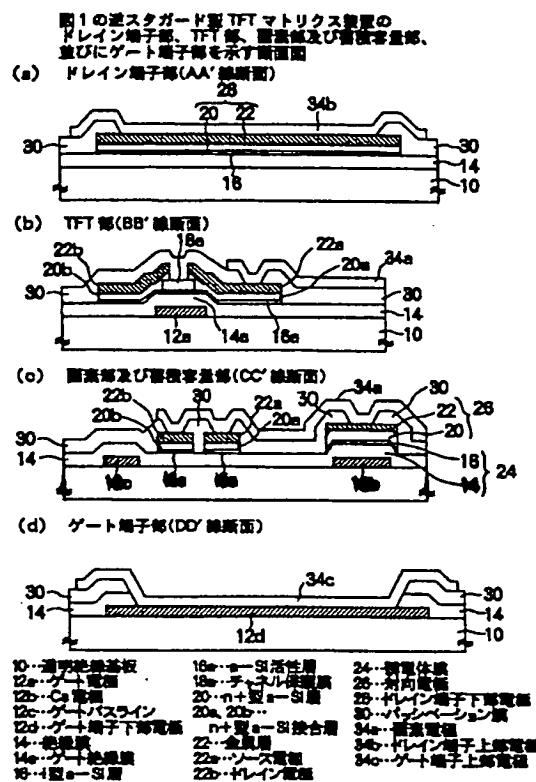
7 2 a、7 2 b、7 2 c … 窓

7 4 … ドレインバスライン

【図1】



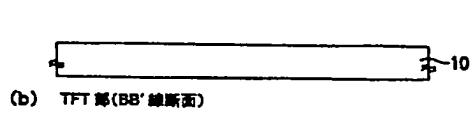
【図2】



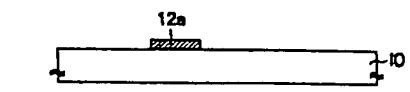
【図3】

図1及び図2の逆スクガード型 TFT マトリクス装置の
製造方法を説明するための工程断面図 (その1)

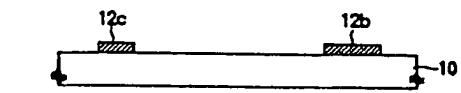
(a) ドレイン端子部(AA' 断面)



(b) TFT 部(BB' 断面)



(c) 圆錐部及び蓄積容量部(CC' 断面)



(d) ゲート端子部(DD' 断面)

10-基板

12a-ノード電極

12b-Ca 薄膜

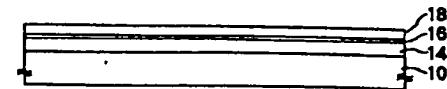
12c-ゲートバスライン

12d-ゲート端子下部電極

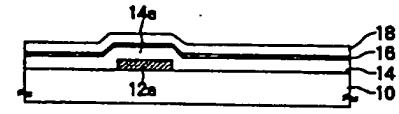
【図4】

図1及び図2の逆スクガード型 TFT マトリクス装置の
製造方法を説明するための工程断面図 (その2)

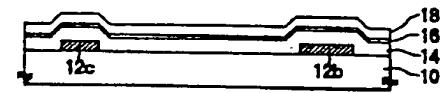
(a) ドレイン端子部(AA' 断面)



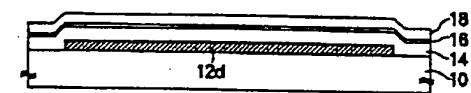
(b) TFT 部(BB' 断面)



(c) 圆錐部及び蓄積容量部(CC' 断面)



(d) ゲート端子部(DD' 断面)



14-遮光膜

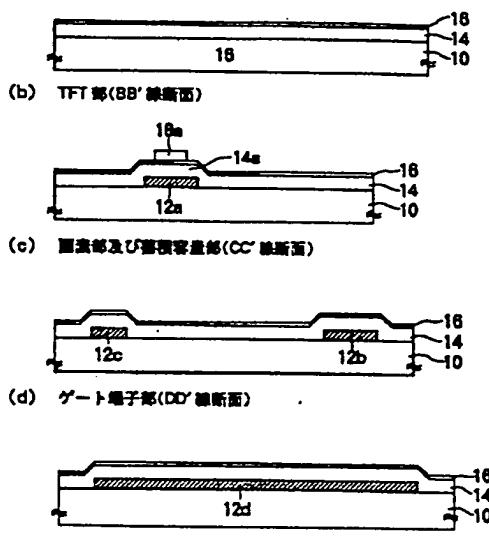
14a-ゲート遮光膜

16-1層～8層

18-電極膜

【図5】

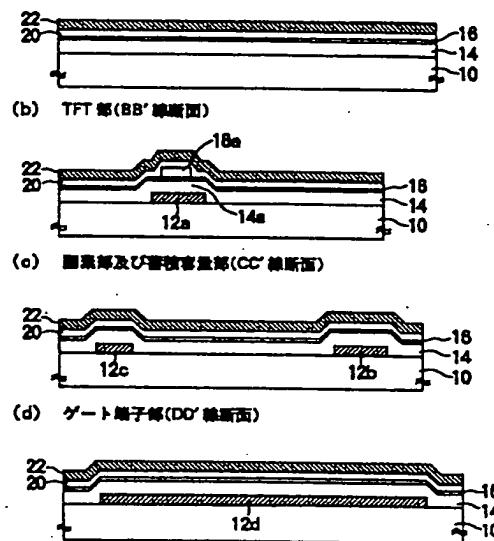
図1及び図2の逆スタガード型TFTマトリクス装置の
製造方法を説明するための工程断面図(その3)
(a) ドレイン電極部(AA'線断面)



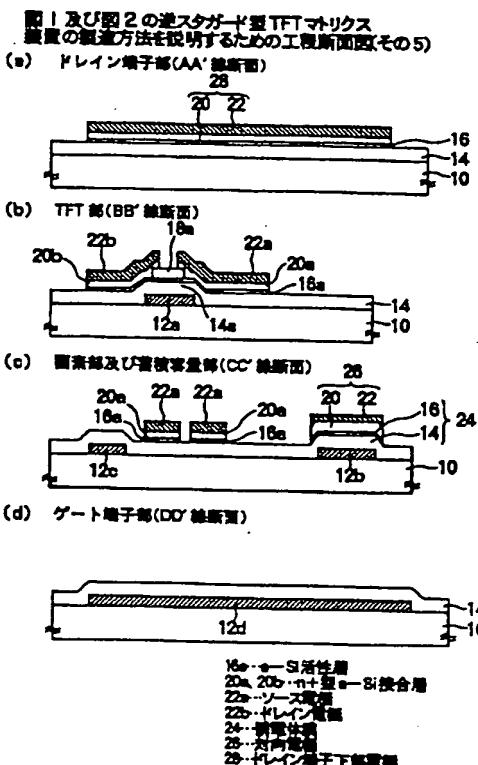
18a・チャネル保護膜

【図6】

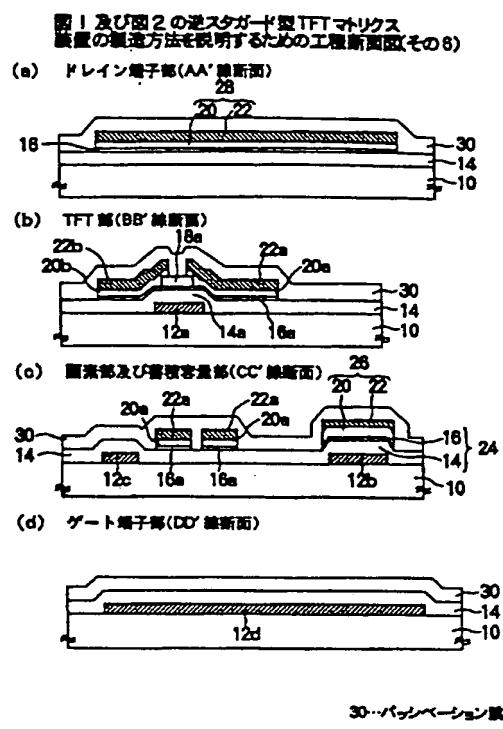
図1及び図2の逆スタガード型TFTマトリクス装置の
製造方法を説明するための工程断面図(その4)
(a) ドレイン電極部(AA'線断面)

20-n+層 a-Si層
22-金属層

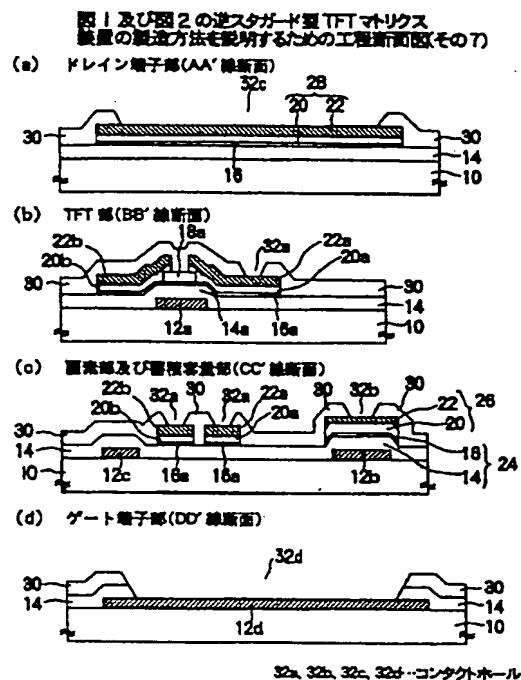
【図 7】



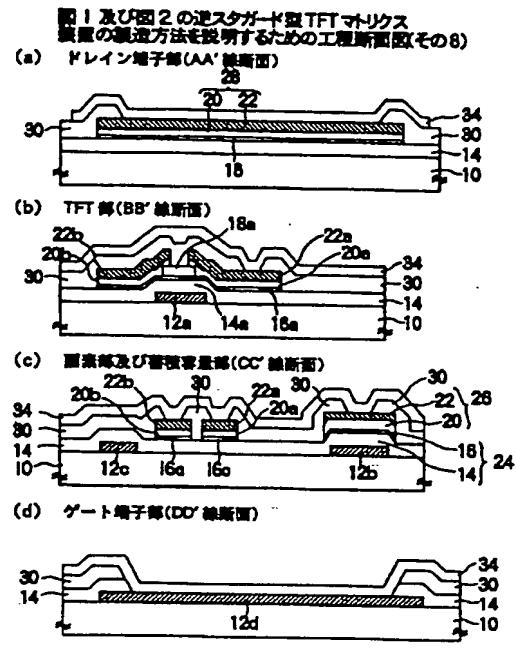
【図 8】



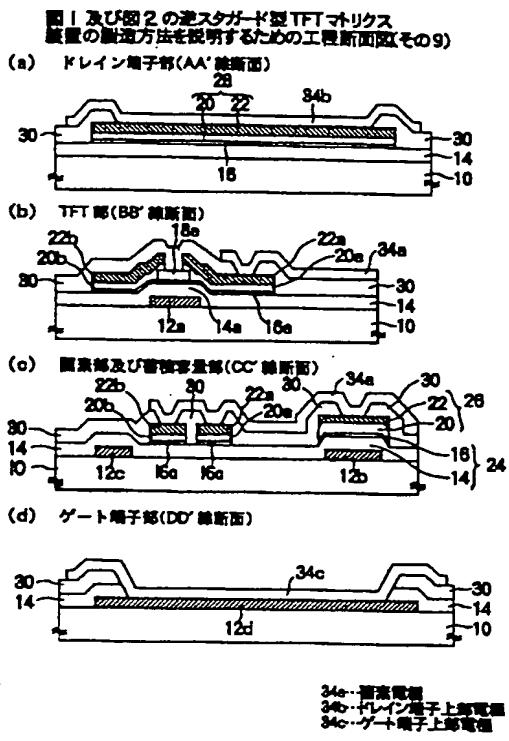
【図9】



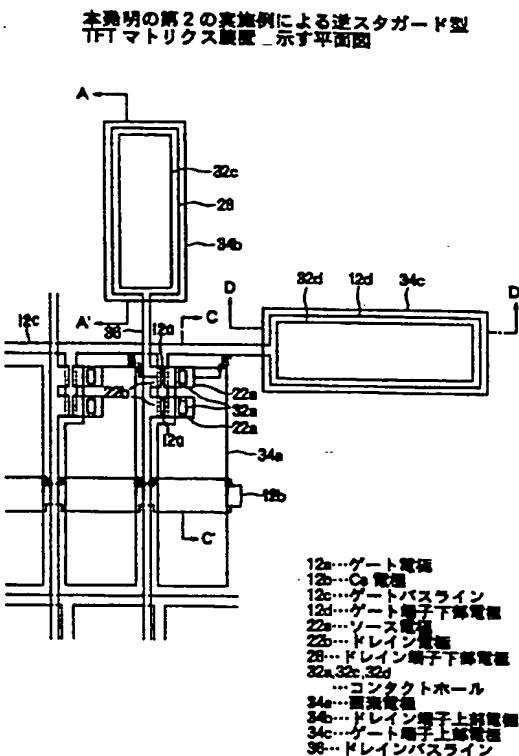
【図10】



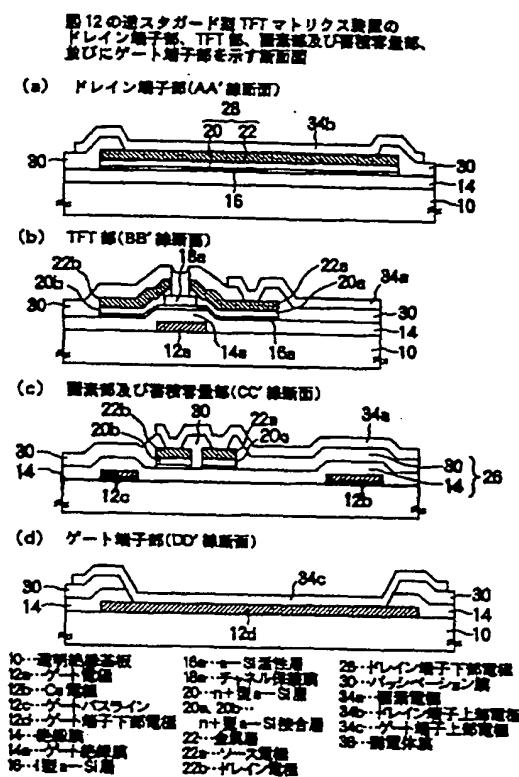
【図11】



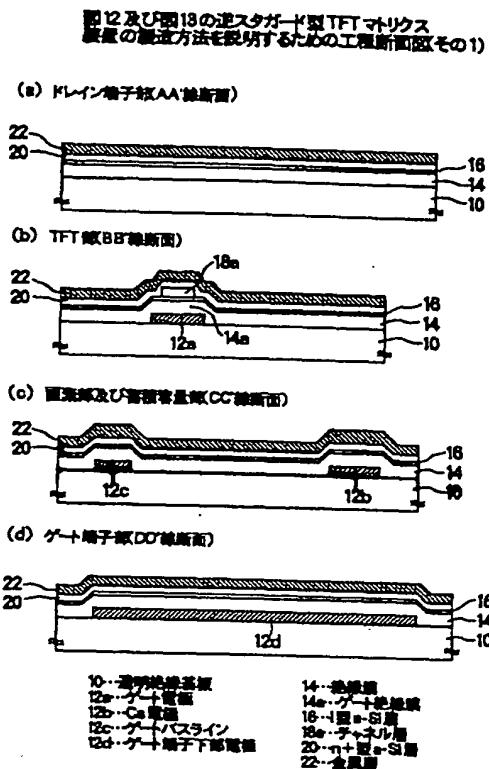
【図12】



【図13】

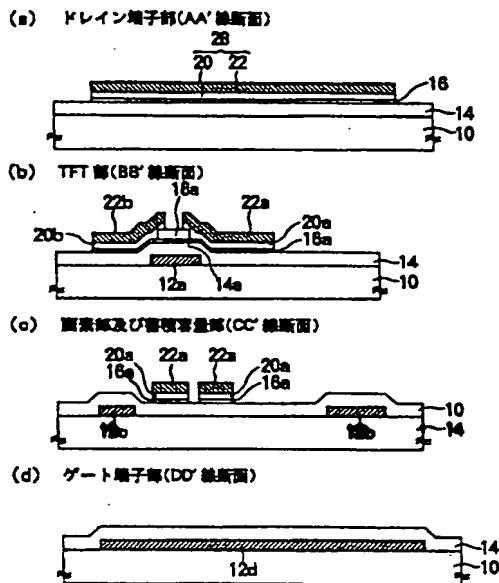


【図14】



【図15】

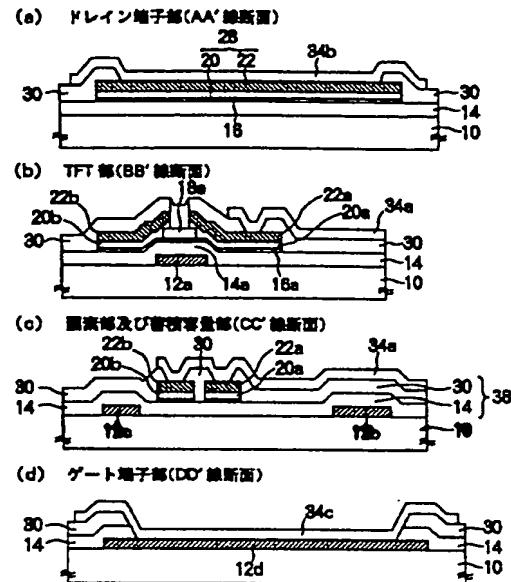
図12及び図13の逆スタガード型TFTマトリクス
素子の製造方法を説明するための工程断面図(その2)



16a...a-Si活性層
20a, 20b...n+層/a-Si接合層
22a...ゲート電極
28...ドレイン電極下部電極

【図16】

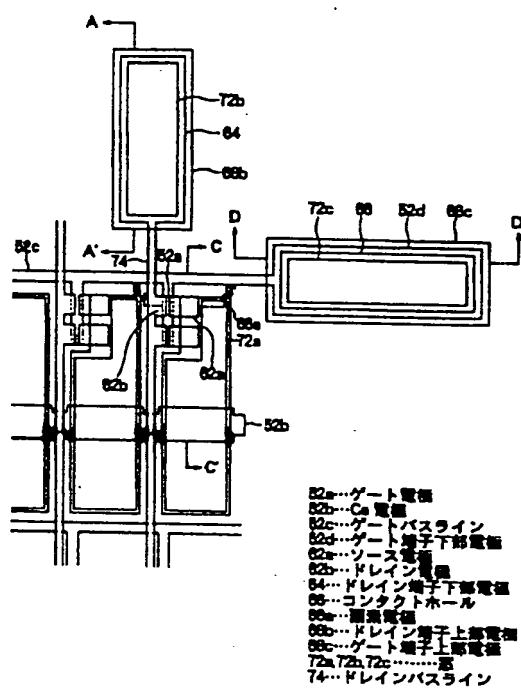
図12及び図13の逆スタガード型TFTマトリクス
素子の製造方法を説明するための工程断面図(その3)



30...バーンバーン層
34a...蓄積電極
34b...ドレイン電極上部電極
34c...ゲート電極上部電極
38...浮遊電極

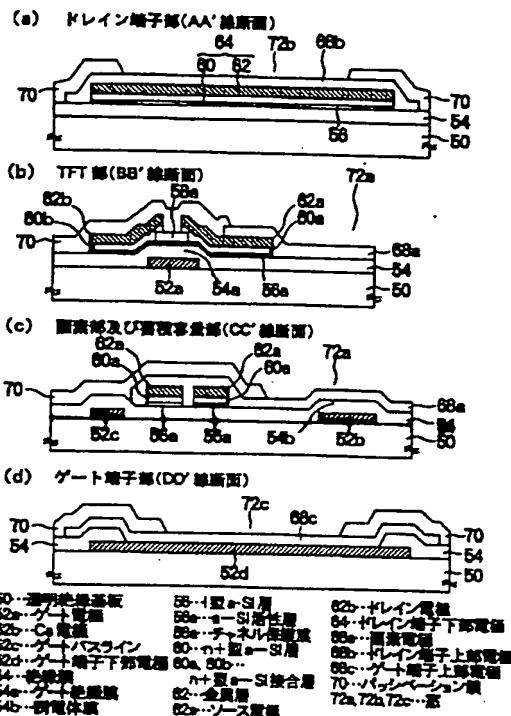
〔四〕

従来の逆スタガード TFT マトリクス駆動を示す平面



[18]

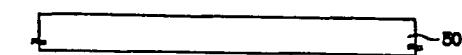
図 17 の逆スカートドレイン TFT マトリクス装置
並びにゲート端子部を示す断面図。



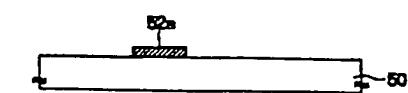
【図19】

図17及び図18の逆ストガード型TFTマトリクス
装置の製造方法を説明するための工程断面図(その1)

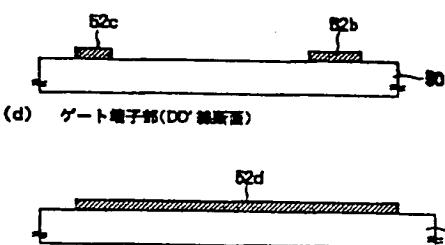
(a) ドレイン端子部(AA' 断面)



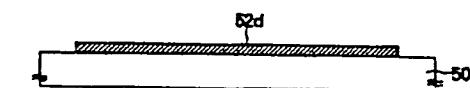
(b) TFT部(BB' 断面)



(c) 電源線及びC電極寄り部(CC' 断面)



(d) ゲート端子部(DD' 断面)

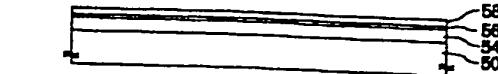


50…遮断遮光基板
52…ゲート電極
53…C電極
52a…ゲートバスライン
52d…ゲート端子下部電極

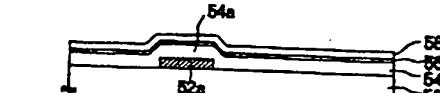
【図20】

図17及び図18の逆ストガード型TFTマトリクス
装置の製造方法を説明するための工程断面図(その2)

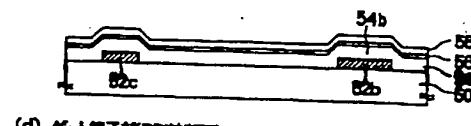
(a) ドレイン端子部(AA' 断面)



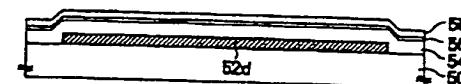
(b) TFT部(BB' 断面)



(c) 電源線及びC電極寄り部(CC' 断面)

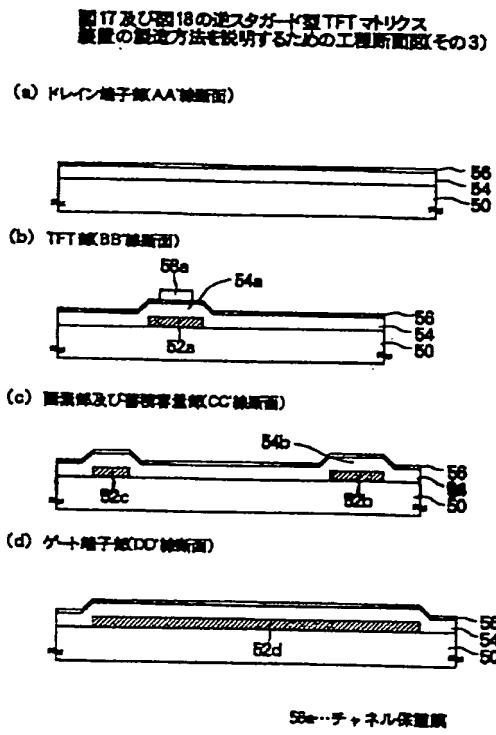


(d) ゲート端子部(DD' 断面)

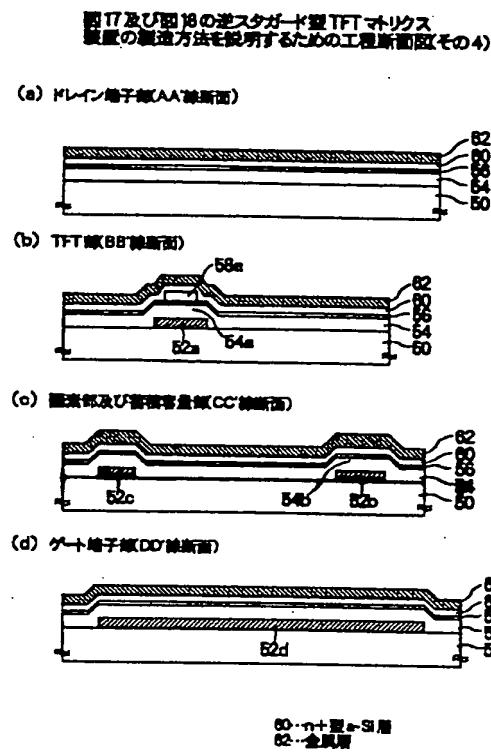


54…遮断遮光基板
54a…ゲート遮断遮光基板
54b…遮断遮光基板
54c…ゲート遮断遮光基板
54d…ゲート端子下部電極
55…遮断遮光基板
56…遮断遮光基板

【図21】

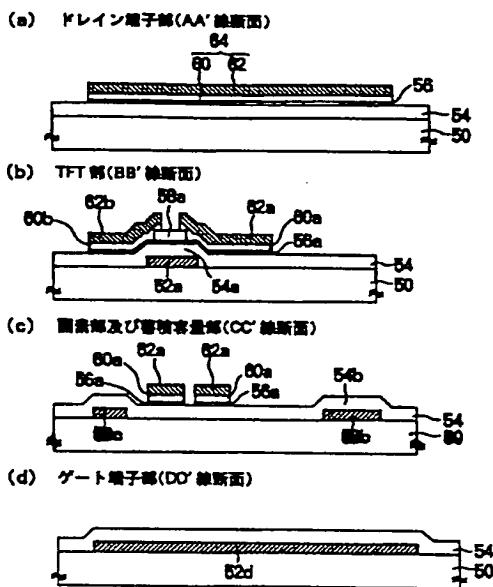


【図22】



[23]

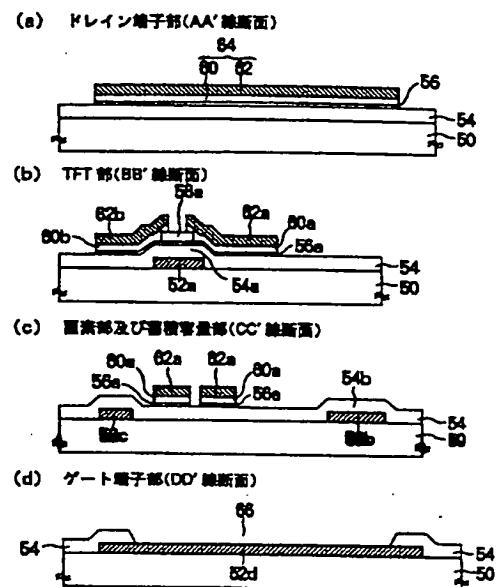
図17及び図18の逆スタガード型TFTマトリクス
製造の製造方法を説明するための工程断面図(その5)



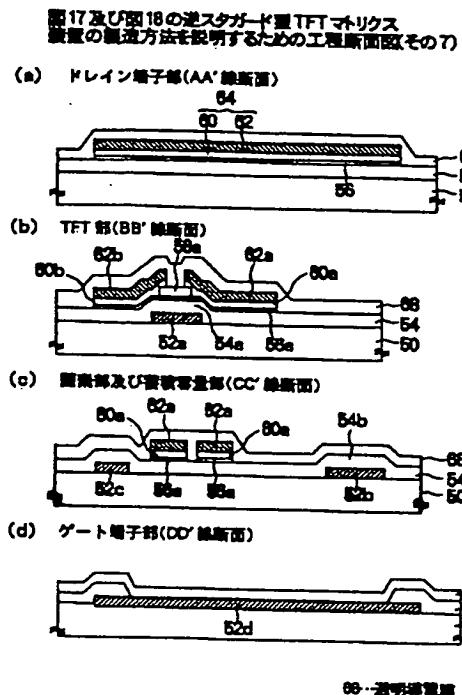
58a. — Si 活性層
60a, 60b. π +層 — Si 接合層
62b. キレイン層
84. キレイン層 + 王水酸化物

【图24】

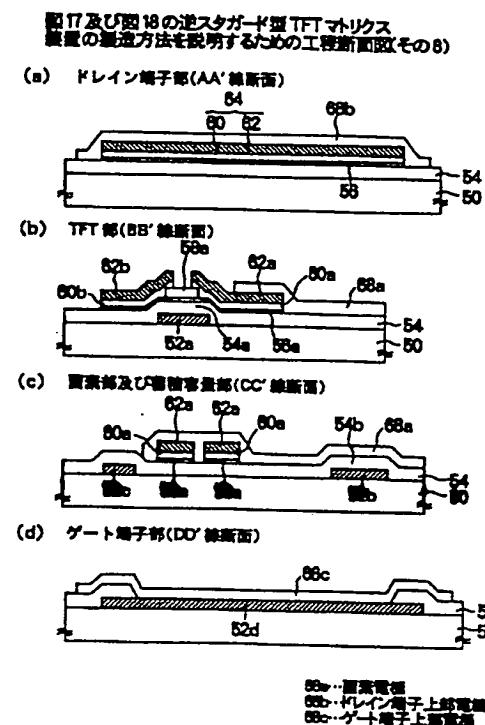
図17及び図18の逆スタガード型TFTマトリクス
装置の製造方法を説明するための工程断面図(その6)



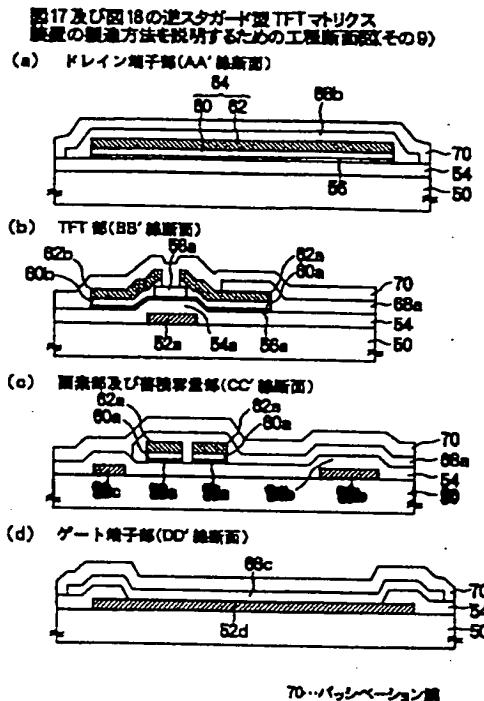
【図 25】



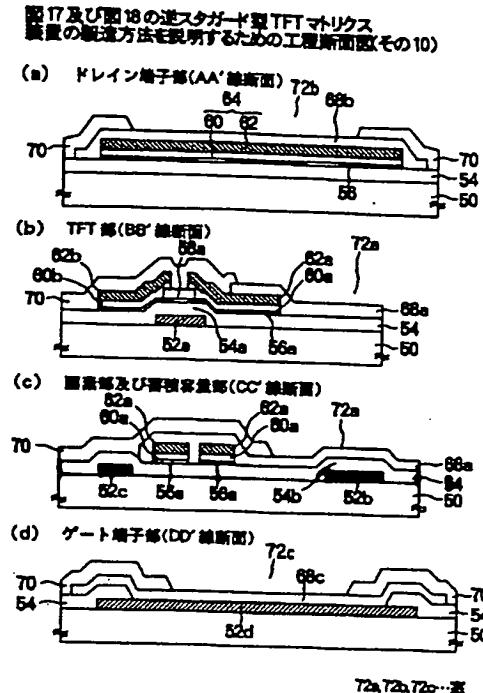
【図 26】



【図27】



【図28】



フロントページの続き

- (72) 発明者 廣田 四郎
神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
富士通株式会社内
- (72) 発明者 野中 一男
神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
富士通株式会社内

- (72) 発明者 佐藤 精威
神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
富士通株式会社内
- (72) 発明者 間島 庭司
神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
富士通株式会社内